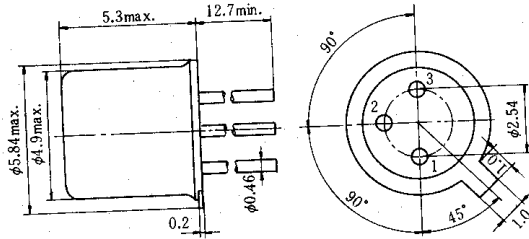


# 2SC1375H

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

高周波増幅用  
高速度スイッチング用

SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR  
HIGH FREQUENCY AMPLIFIER  
HIGH SPEED SWITCHING



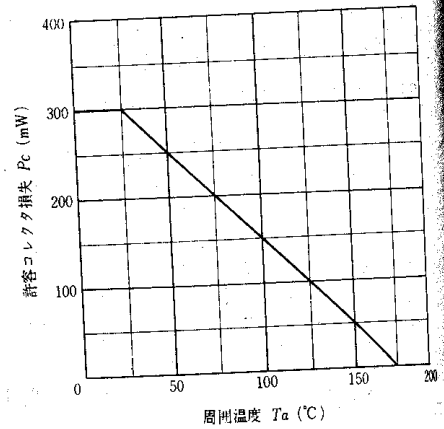
1. エミッタ: Emitter
  2. ベース: Base
  3. コレクタ: Collector
- (ケース) (Case)  
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	2SC1375H	Unit
コレクタ・ベース電圧		$V_{CBO}$	25	V
コレクタ・エミッタ電圧		$V_{CEO}$	10	V
エミッタ・ベース電圧		$V_{EBO}$	4	V
コレクタ電流		$I_C$	100	mA
許容コレクタ損失		$P_C$	300	mW
接合部温度		$T_j$	175	$^\circ\text{C}$
保存温度		$T_{stg}$	-65 ~ +175	$^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失による周囲温度の変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	25	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, R_{BE}=\infty$	10	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$	4	—	—	V
コレクタ遮断電流		$I_{CBO}$	$V_{CB}=5\text{V}, I_E=0$	—	—	50	nA
直流電流増幅率		$h_{FE}$	$V_{CE}=0.4\text{V}, I_C=50\text{mA}$	54	—	—	
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=1.2\text{mA}$	—	—	0.9	V
ターンオン時間		$t_{on}$	測定回路参照	—	—	45	ns
ターンオフ時間		$t_{off}$	See Test Circuit	—	—	60	ns